

(11)Publication number:

02-178953

(43) Date of publication of application: 11.07.1990

(51)Int.CI.

H01L 23/29

H01L 23/31

(21)Application number : **63-331531**

(22)Date of filing:

29.12.1988

(71)Applicant : **NEC CORP**

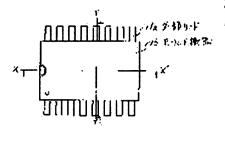
(72)Inventor: UNO TAKAYUKI

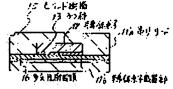
(54) RESIN-SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent cracks generated in a package, defects such as peeling and the deterioration of moisture resistance by forming a porous resin film onto the rears of a semiconductor-element loading section and the hanging lead of the semiconductor-element loading section.

CONSTITUTION: A porous resin film 16 is shaped onto the rears of a semiconductor-element loading section 11, and a hanging lead 11'a thereof. Since the porous resin film 16 has the high coefficient of water permeability, steam is discharged through the porous resin film 16 even when moisture in a package is vaporized and expanded suddenly due to thermal stress at the time of mounting to a printed board, etc., thus preventing the increase of stress of the inside of the package. Adhesion with a molding resin 15 can be





augmented by selecting the kind of the porous resin film 16. Accordingly, cracks generated in the package, defects such as peeling and the deterioration of moisture resistance can be obviated.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application ther than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

❷日本国特許庁(JP)

@ 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-178953

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成2年(1990)7月11日

H 01 L 23/29 23/31

0412-5F' H 01 L 23/30

В

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

公発明の名称 さ

谢脂封止型半導体装置

②符 頤 昭63-331531

黎出 顯 昭63(1988)12月29日

100 発明者字

隆 行

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

⑩出 顯 人 日本電気株式会社

野

東京都港区芝5丁目7番1号

砂代 理 人 弁理士 内 原 晋

班 超 包

発明の名称

樹脂對止原半導体装置

特許請求の範囲

少なくとも辛募体業予報選割及び半導体業予報 置部の吊りリードの裏間に多れ代納脂膜を設けた ことを特徴とする制度対止型半導体装置。

発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は総勝封止型半港会装置に関する。

〔從寮の技術〕

能来の傾脂対止選集導体設置は第3図(a), (b),(c)に示すように、数系又は網系の合金から成るリードフレームの半導体器子設図部 3 I ′ b (アイランド) に半導体器子3 2 を供べ 一スト等のろう何3 3 により固者し、次いで金等 のボンディングワイヤ3 4 により、半導体器子 3 2 と内部リード 3 1 b とを選気的に接続した 競、モールド機能 3 5 で対止し、外部のリードを 加工規形した構造を有していた。

(発明が解放しようとする課題)

上途した従来の関係對止選半導体装置は、做 量ではあるが空気中の水分を吸収しているため (0.1~0.4w t %程度)、プリント造板等 に実致する既の拠ストレスにより上端吸温水分が パッケージ内部で気化酸張し、パッケージ内部に クラックや到離を生じさせ、さらには耐湿性が劣 化してしまうという欠点がある。

特に、近年、半時体業子の無限度増大に伴い業子サイズが大型化する一方、高度度実践の要求に 伴いパッケージの軽階短小化が進むことで、実装 ストレスに耐え得るパッケージ強度を確保するの が非常に困難になりつつある。

「裸題を解決するための手段)

本発明の機能對止型半導体業置は、少なくとも や媒体選手能散部及び半導体素子規数部の吊りリ ードの製陶に多孔性樹脂膜を設けたというもので

特別平 2-178953(2)

ある.

(契銘例)

次に本発明について図面を参照して説明する。 解1図(a)は本発明の第1の実施例の平可 図、第1図(b)は第1図(e)の又一×、原所 両図、第1図(c)は第1図(e)のソーヤ、最 断形図である。

-3-

断面図である.

本実施例では半導体器子22並びにポンディングワイヤ24との経統部及び外部リード21a以外の金属部(つまり半導体器子構轄部21~bの 裏面、吊りリード21~a及び内部リード21b〉 ほぼ全面に多孔性側筋膜26を設けている。 (側脂膜の形成条件は第1の契旋側と同じてある。)

で、 で学事体業子報でおのみならず、 的部りの部とのが認知がなされ、より一切、内部 大脳発生を防止することができる。またモルド 関語とので着力も全体的に高まることがらストレン スを分散することが可能であり、このことからも 内部欠陥発生際止の効果が期待できる。実際、 のの数を際止の効果が期待できる。 大路のであり、 大路のであり、 大路のであり、 大路のであることが可能であり、 大路のであることが可能であり、 大路のである。 大路のでる。 大路のである。 大路のである。 大路のである。 大路のである。 大路のである。 大とのでな。

(発明の効果)

以上説明したように本発明は、少なくとも半導体素子裁難部及びその吊りリードの裏面に多孔供 樹脂膜を設けることにより、プリント勘収等へ実 上述の多孔性間路酸は潜水市高いため、プリント基板等への実施時における無ストレスもも、多数にパッケージ内の水分が無出される。との一般である。とのでは、から、アリントでは、から、できる。というでき、中面が低速の効果も高めることができ、中面が低速の効果をあることができ、中面が低速の効果をあることができ、中面が低速の効果をある。というでき、中面が低速の効果をある。というでき、中面が低速の効果をある。

64ビン・ブラット・モールド)でも本契施例 で試作し、半田後し続の125℃、相対温度(発 以)100%のブレッシャクッカ議験PCTを行った結果を第4回に示す。

従来例に比して剪しく改要されていることが判る。

第2日(a)は本名明の第2の実施例の平面四、第2日(b)は第2日(a)のX-X~線所面図、第2日(c)は第2日(a)のY-Y~線

- 4 --

表する際の無ストレスにより発生する水酸気をパッケージ外部に排出し、さらにモールド側膜との 密者力も高められることから、パッケーシ内部に 発生するクラックや糾雑等の欠陥の発生を防止で さ、樹飼料止理学等体装置の耐湿性劣化を防止で きる効果がある。

図館の簡単な説明

部1図(a)は本発明の第1の実施例の平面図、第1図(b)は第1図(a)のX-X・級所の図、第1図(c)は第1図(a)のY-Y・級所図、第2図(a)は第2図(a)のY-X・終所図ののでは第2図(a)のY-Y・終所の図、第3図(a)のX-X・機所の図、第3図(a)のX-X・機所の図、第3図(b)は第3図(a)のX-X・機所の図、第3図(c)は第3図(a)のY-Y・終所の図、第3図(c)は第3図(a)のY-Y・終所の図、第3図(c)は第3図(a)のY-Y・終所の図、第3の図(c)は第3図(a)のY-Y・終所の図、第3

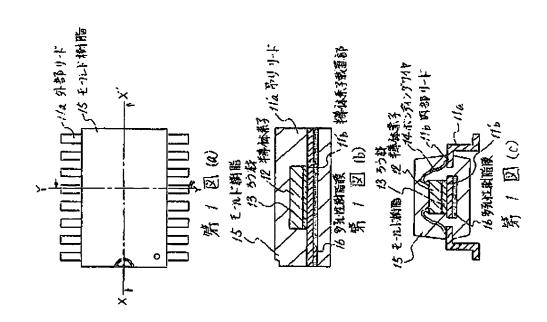
11a, 21a, 31a--外部リード、11

-6-

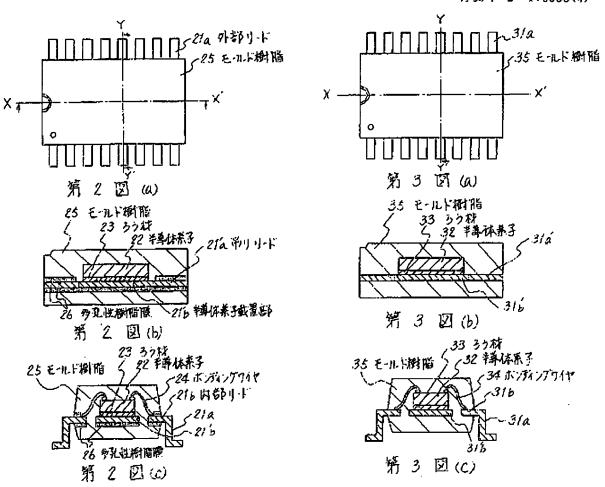
特闘平 2-178953(3)

り、216、316…内部リード、1114。 ンド〉、21、22、32…半導体影子、13. 23、33…ろう材、14、24、54いポンデ 雅、16.26…多孔茂宏黯睽。

代理人







	ap.	多孔性	细爱し我	PCT使累積不良率		
水準		树脂膜	バルジグラクを生	化時間	加明	288 時間
第1の 実施例		わり	13 %	6%	9%	9%
第2の 実施側		あり	0%	0%	0%	3%
散来例		\$ L	100%	16%	34%	44%
備考	・試料: 64ピン・フラット・モールドIC ・素子: 耐湿性評価専用テスト素子 ・試料数: 各32 ・評価条件、フロー: 85℃,85% RH、72時間保管 240℃.103、半町丸浸し 125℃,190%、PCT					
	· PCT不良内容: 開放(AL溶け)					

陆 / 197

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☑ BLACK BORDERS
☑ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☑ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.